



F.I.SH.: Ismoilov Shavkat Qo'ziyevich

LAVOZIM: dosent

TEL: +998999617524

E – mail: shavkat6819@mail.ru

TASHKILOT TEL: +99862 2246700

TASHKILOT MANZILI: Urganch shahar Xamid Olimjon ko'chasi 14. 220100

DARAJASI	<ul style="list-style-type: none"> • 1985 – 1990 – TashDU, fizika fakulteti, talaba; • 1981 – 1992 – matematika Instituti UzFA, stajer-tadkikotchi; • 1998 – 2001 – Fizika – texnika instituti UzFA, aspirant,
TAJIRIBA	<ul style="list-style-type: none"> • 1993 – 1998 – UrDU, stajer – o'qituvchi, • 2001 – 2008 – Urganch Davlat Universiteti ,assistant, • 2008 – xozirgi kungacha – Urgench Davlat Universiteti «Fiziki» kafedrasida dotsenti.
MUTAXASSISLIGI	<ul style="list-style-type: none"> • Yarimutkazgichlar va dielektriklar fizikasi.
O'QITADIGAN FANLARI	<ul style="list-style-type: none"> • Termodinamika va stat.fizika, Nazariy mexanika, Molekulyar fizika, Mikroelektronika
TADQIQOT ISHI	<ul style="list-style-type: none"> • Выращивание и исследование электронных и оптических свойств твердых растворов $(Ge_2)_{1-x}(InP)_x$ ($0 \leq x \leq 1$)
TADQIQOTLARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выращивание кристаллические совершенных Si – SiGe–$(Ge)_{1-x}(InP)_x$ структур из жидкой фазы. Письма в ЖТФ, 1999, том 25, вып. 24, стр. 37-40. 2. Токопрохождение в pSi$_{1-x}$ – Ge$_x$ – n$(Ge_2)_{1-x}(InP)_x$ структурах. ДАН РУз. Ташкент, 2005, № 2 стр. 23-25. 3. Optical Properties of $(Ge_2)_{1-x}(InP)_x$ Solid Solution. Technical Physics Letters, 2006, vol. 32, № 6. pp. 538-541. 4. Электронная структура твердого раствора $(Ge_2)_{1-x}(InP)_x$, УФЖ, Ташкент, 2006, № 6. УФЖ, Ташкент, 2006, № 6. 5. Оптические свойства твердого раствора $(Ge_2)_{1-x}(InP)_x$. Письма в ЖТФ 2006, т. 32, вып 12, 63-70 стр 6. Электронная структура твердого раствора $(Ge_2)_{1-x}(InP)_x$. // УзФЖ, Ташкент, 2007, № 1. 7. Прогноз процессов льдаобразования в водных ресурсах Хорезмского оазиса. Илм сарчашмалари 2011, 9-сон, 56-58 б. 8. Киришмаларнинг кристалл музда эрувчанлигига масаласига доир. Илм сарчашмалари журналы 2012 й. N 2 9. Выращивание эпитаксиальных слоев $(Sn_2)_x(InSb)_{1-x}$ на GaAs подложке из жидкой фазы. Илм сарчашмалари журналы, 2016 г. №8 10. Яримутказгичлар ва диэлектриклар физикаси фанидан электрон ўқув модули ишланмасини яратиш. Илм сарчашмалари 2016 й. № 12 11. Simulation of parametrs of nGe-pSiGe diode structures on TCAD SENTAURUS. “Actual problems modern science education end training in the region” Electronic scientific edited volume 1. 2017 42-46 p.

	<p>12. Жидкофазная эпитаксия твердых растворов $(\text{Ge}_2)_x(\text{InP})_x$ и $(\text{GaAs})_{1-x-y}(\text{Ge}_2)(\text{ZnSe})_y$. "Технологии Техника Инженерия" Международный научный журнал № 2.1 (4.1) / 2017 г., стр.28-30</p> <p>13. О зонной структуре твердого раствора $\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$. Образования и воспитания, Международный научный журнал № 3.1 (18.1) / 2018 г., стр. 24-</p>
<p style="text-align: center;">HOZIRGI TADQIQOTLARI</p>	<p>1. Выращивание эпитаксиальных слоев $(\text{Sn}_2)_x(\text{InSb})_{1-x}$ на <i>GaAs</i> подложке из жидкой фазы. Илм сарчашмалари журналы, 2016 г. №8</p> <p>2. Яримўтказгичлар ва диэлектриклар физикаси фанидан электрон ўқув модули ишланмасини яратиш. Илм сарчашмалари 2016 й. № 12</p> <p>3. Simulation of parametrs of nGe-pSiGe diode structures on TCAD SENTAURUS. "Actual problems modern science education end training in the region" Electronic scientific edited volume 1. 2017 42-46 p.</p> <p>4. Жидкофазная эпитаксия твердых растворов $(\text{Ge}_2)_x(\text{InP})_x$ и $(\text{GaAs})_{1-x-y}(\text{Ge}_2)(\text{ZnSe})_y$. "Технологии Техника Инженерия" Международный научный журнал № 2.1 (4.1) / 2017 г., стр.28-30</p> <p>5. О зонной структуре твердого раствора $\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$. Образования и воспитания, Международный научный журнал № 3.1 (18.1) / 2018 г.</p>